PLASMA ETCHING METHOD

Patent Number:

JP57049234

Publication date:

1982-03-23

Inventor(s):

YAMAZAKI SHUNPEI

Applicant(s)::

SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD

Requested Patent:

JP57049234

Application Number: JP19800124384 19800908

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/302

EC Classification:

Equivalents:

JP1615186C, JP2000850B

Abstract

PURPOSE:To improve the reliability of dry etching step by employing nitrogen and compound of halogen elements as reactive gas, eliminating detrimental carbon in the plasma, and etching Si, silicide, metal or the like.

CONSTITUTION: A specimen 3 to be worked made of silicide, e.g., Si or Si3N4 or the like is placed on a specimen tray 4 of a device container 1, and reactive gas NF4, hydrogen, oxygen or inert gas is introduced via pipes 9, 10. The NF4 is activated by microwave in an activation chamber 5 to produce fluorine radical to etch the specimen 3. When a resist mask is covered, for example, on the specimen 3, it can be selectively etched. The reactive gas may employ chlorided nitride. Solid powder of fluorided ammonium, chlorided ammonium is contained in the chamber 5, inert gas is introduced to produce plasma radical by microwave or the like, and it can thus be etched.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(i): 日本国特許庁 (JP)

11 特許出願公開

取公開特許公報(A)

昭57-49234

€i⁄Int. Cl.³ H 01 L 21/302 識別記号

庁内整理番号 7131-5F

43公開 昭和57年(1982) 3 月23日

発明の数 審査請求。有

(全 3 頁)

60プラズマエッチング方法

全边生车

願 昭55 -- 124384

29出

願 昭55(1980)9月8日

70発 明 者 山崎舜平

東京都世田谷区北烏山7丁目21

番21号株式会社半導体エネルギ 一研究所内

毎出 願 人 株式会社半導体エネルギー研究

東京都世田谷区北烏山7丁目21

番21号

細

1.発明の名称

プラズマエッチング方法

2.特許請求の範囲

- 1. 原素とハロゲン元素との化合物をプラズマ化し、 膜または金属または金属化合物粘膜をエッチングす ることを特徴とするプラズマエソチック方法。
- 2. 特許方求の適用第1項において、マソ化館区をブ ラメマ化することにより珪素または荘 煮化合物をエ シチングすることを特徴とするプラブマエツチング 方法。
- 3. 特許請求の範囲第1項において、塩化窒素により 金属または金属化合物被膜をエッチングすることを 特徴とするプラズマエソチング方法α

ツチングの反応性気体に用いることにある。

近年エフチング技術を必要とする分野、例えば半導体 **集積回路の製造工程におけるエッチングには従来のエッ** チング溶液を用いたウエットエソチングのかわりに反応 性ガスを用いたドライエンチングが開発されつつある。

このドライエソチングは工程の簡略化等の特徴および デバイスの信用性の向上をはかるととができるとされて いる。このためエリチンプガスはハロヤン元素例えばフ ツ塞、塩素の化合物特につき、リロコをブラズマ中にて 分解し、E、c Tを発生させていた。しかし同時に固体 である炭素が存在し、これが半導体の信頼性向上の面で はきわめて有害なものであることが判明したo

とのためとのでき、CCLのガス中に0.1~5角酸 要を入れてのガスにしてしまりことが程々されているo しかしとのプラズマ中での炭素と酸素との化合は必ず

本発明は窒素とハロゲン元集との化台物をプラズマエ

4.注がある。これはこの気体がきわめて酸性であり、関

[★]整明与詳細支部冊

応容器、つぎ手、真空ポンプ等が脂融しやすく大きな問題になつてしまつた。

本発明は化学的に安定を気体でありまた活性化または分解せしめた時ハロゲン元素とその削売物が経帯で気体である空糞のハロゲン化物的にフッ化窒素(NF、NF、NF以NNOLがはなる)を用いた。さらにこのNF、NCLの水素化物であるファ化アンモニューム(NH,CL)の関体をブラズマ中にて活性化、分解して、N、NLの安定な気体とフン菜、塩素ラジカルを発生させることを他の特徴としている。

ことでは第1回にデすようにたて型のエッチング系を用いた。すなわちエッチング容器(1)には試料台(4)上にて試料(3)がのせられている。反応性気体はNP,を(9)よりまた水素、酸器または下活性ガスを(10)よりあ入した。

活性化室(5)にてマイクロ改発生源(6)にて 2 . 4 5 G H 2 1 . 3 5 K W 県大の言量を有するマグネトロンよりアラニユエイター(7)を経て反応性サスを活性化室(5)にて活性

にする。 すると

N F, → N*+3F*

2 N' - N.7

F+Si - SiFit

の反応により試料のエッチンプされるべき物が単結晶、 多結晶、アモルフアスまたはセミアモルフアス制造の珪 器においてはロエスとなつでエッチングされた。またと の後エッチング材は湿化圧が、酸化アルミニューム、酸 化珪昌等であつてもよい。

反応祭器の圧力は排鉄口のストップバルブ(i)、ニード ルバルブ的またはロータリーボンブ的より調整した。

基板または蒸板上の被配を定択酸化するには、フォトレジスト例えば 0 M R B 3 (東京応化製) を用いレジストパターンにより 1 μ中のスリツト開口を設け、開口部のみをエンチングすればよい。

エンチング時の容器の圧力は 0、 0 1 ~ 0 . 5 t o r r としたが、一般に 0 . 0 5 ~ 0 . 5 t o r r がサイドエ ツチもなく徴継バターンを切ることができた。

試料は1c0~—30°cの範囲にて制御した。 特にと

れに水梁を1~108混入して酸化珪膏をエフチンプす

る時に10~-15°Cに冷しておく方がパターンのがけがエフチング速度を2000A/グー300A/分とトげることができきれいてあつた。

4 0 1, - 11 + 10 1

: N -- N,

4 C 1 + A 1 - A 1 C 14T

であり、さらにここに大烈を0.1~10多添加してパ ターンのされをよくしてもよい。

さらにまた、本発明においては活性化溶に固合例をは 粉末の耳氏を、NHHBをおき同時に日日、AFMガブ これは塩化アンモニユームを用いても同様である。

本発明は注発すたはその化合物のプラズマェッチング を示した。しかし 0 a A a 、 I n P 、 B P 等のプラズマ エソチングにおいても同様であり、さらにこれらの酸化 物、簡化物に対しても適用できる。

またプラズマエッチング制はマイクロ前のみではなく 13.36Mドロの高風遊声が設置結合形、静労特合則 単行平板形のエコインブ技術においても同様である。

またとの反正性例信をスポッタエッチング#M4 反応スペッタエッチングに用いてもよいととはいうまでもない。
4.図面の簡単を説明

第1回は本発明を用いたプラブマエッチング系の概要を示す。

新事的は目り、ジャにより減らすからなか対しばれる 密駅的にエングングはせるととができる。 7.90 出版 4



